

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 1XV754J	文件编号	XS-R-244
	肖特基二极管	版本号	17-A1-08
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

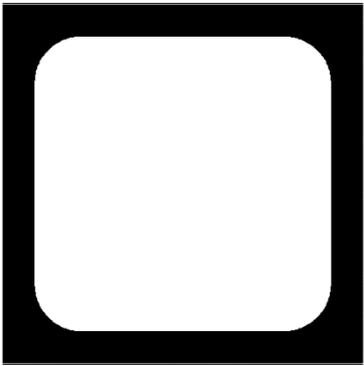
1.1 主要用途

用 1XV754J 封装的成品管用于开关电源、高频逆变器、极性保护电路等各类电子电路上。

1.2 主要特点

- 高 ESD 能力
- 低正向、低漏电
- 高正向浪涌能力

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	2.4×2.4	
	芯片厚度 (μm)	200±20	
	划片道尺寸 (μm)	60	
	键合区面积 (μm ²)	正面	2100*2100μm
	正面电极 (阳极)	金属	铝
		厚度 (μm)	4±0.4
	背面电极 (阴极)	表层金属	银
	硅片直径 (mm)	φ150	
	装片要求 (推荐)	焊料	
键合要求 (仅供参考)	铝丝: φ380 μm、2 根		

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	100	V	推荐封装形式: T0-220/T0-3P 推荐成品型号: MBR30100CT 或 MBR20100CT
正向电流	$I_{F(AV)}$	15	A	
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	220	A	
结温	T_j	150	°C	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	°C	

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

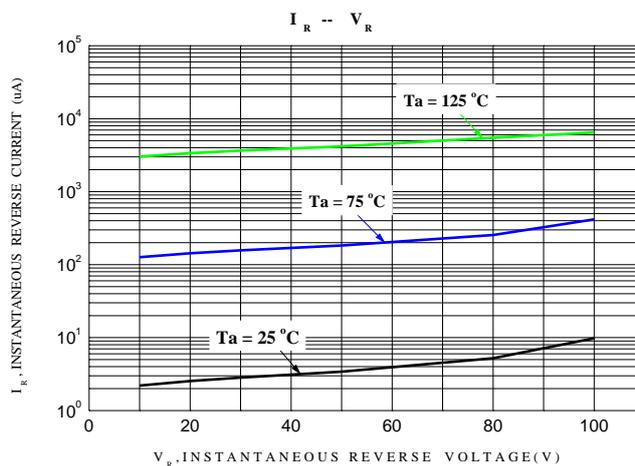
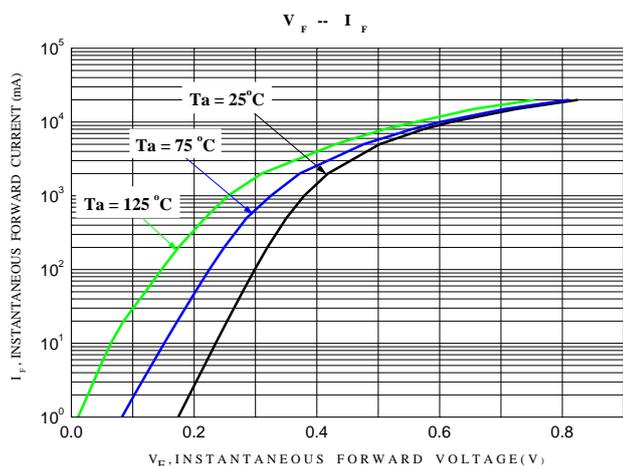
	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 1XV754J	文件编号	XS-R-244
	肖特基二极管	版本号	17-A1-08
		页码	2/2

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=0.1\text{mA}$	100	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R=100\text{V}$	—	10	100	μA
正向电压	V_{F1}	$I_F=1\text{A}$	—	0.39	0.43	V
正向电压	V_{F2}	$I_F=3\text{A}$	—	0.45	0.49	V
正向电压	V_{F3}	$I_F=5\text{A}$	—	0.50	0.54	V
正向电压	V_{F4}	$I_F=10\text{A}$	—	0.62	0.66	V
正向电压	V_{F5}	$I_F=15\text{A}$	—	0.71	0.76	V

3.3 典型特性曲线



注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

传真: (0510) 86851532